

VALTIONTUET – SAKSA

Tuki C 86/01 (ex N 334/01) – Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(2001/C 368/02)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio on ilmoittanut 28. marraskuuta 2001 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Saksan liittotasavallalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua tukea.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa tuesta, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa, kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen

Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto (DG COMP)
Linja H
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Faksi (32-2) 296 98 16

Huomautukset toimitetaan Saksalle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä käsittelemistä luottamuksellisena, ja tämä pyyntö on perusteltava.

YHTEENVETO

Menettely

Saksa ilmoitti 22. toukokuuta 2001 aikomuksestaan myöntää alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille annettujen monialaisten puitteiden (jäljempänä "monialaiset puitteet") nojalla tukea Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG:lle uuden dynaamisia käyttömuisteja (DRAM) valmistavan tehtaan rakentamiseen. Komissio pyysi lisätietoja, jotka Saksan viranomaiset toimittivat 3. heinäkuuta 2001, 5. heinäkuuta 2001, 24. syyskuuta 2001 ja 22. lokakuuta 2001 päivätyillä kirjeillä. Saksan viranomaisten viimeinen kirje lähetettiin 22. marraskuuta 2001.

Kuvaus

Tuensaaja Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG (jäljempänä "SC 300") perustettiin helmikuussa 1998 müncheniläisen Infineon Technologies AG:n (jäljempänä "Infineon") 87-prosenttisesti omistamana tytäryhtiönä. Infineon, joka on Siemens AG:stä irrotettu puolijohdeiden valmistaja, listautui pörssiin maaliskuussa 2000.

Hanke sijaitsee Dresdenissä Sachsenin osavaltiossa, joka on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan

mukainen tukialue. Suuryrityksille myönnettävän tuen suurin sallittu intensiteetti alueella on 28 prosenttia brutto.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa tuotantolaitos, jossa valmistetaan halkaisijaltaan 300 mm:n kiekkoista DRAM-piirejä, joiden viivaveveys on 0,14 µm tai sitä pienempi. Tehtaasta tulee maailman ensimmäinen DRAM-piirejä 300 mm:n kiekkoista valmistava tuotantolaitos. Saksa korostaa, että Infineon on EU:n ainoa DRAM-valmistaja. Tuotantokapasiteetin odotetaan nousevan ajan mittaan 5 000 kiekkoon viikossa. Tuotannon lisäksi SC 300:n on tarkoitus harjoittaa pilotti- ja kehitystoimintaa tehtaan jo nyt toimivassa osassa.

Valmistettavat tuotteet ovat 512 megabitin ja sitä suurempia DRAM-piirejä. Nämä korvaavat vähitellen 256 megabitin ja pienemmät käyttömuistit. Uusi 300 mm:n tekniikka parantaa tuottavuutta ja supistaa tuotantokustannuksia.

Saksan mukaan hankkeen ansiosta luodaan 1 300 pysyvää uutta työpaikkaa ja turvataan 400 vanhaa. Lisäksi Saksan mukaan hankkeen toteuttaminen johtaa välillisesti 1 030:n uuden työpaikan luomiseen alueella. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat 1 106 miljoonaa euroa, joka on kokonaan tukikel-poista.

Ehdotettu tuki koostuu alueellisen talousrakenteen parantamista koskevan Saksan liittovaltion ja osavaltioiden yhteisen 29. puiteohjelman nojalla myönnetystä 88 073 000 euron (172 255 000 Saksan markan) investointituesta, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja vuonna 1999 annetun veronhuojennuksia koskevan lain nojalla myönnetystä 128 850 000 euron (252 000 000 Saksan markan) investointilisästä. Lisäksi hanketta varten otettavalle 450 miljoonan euron (880 miljoonan Saksan markan) lainalle myönnetään 80 prosentin valtiontakaus. Kun muille kuin vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävän lainatakauksen tuki-intensiteetti on 0,5 prosenttia, takauksen arvo tukena on 1 800 000 euroa (3 520 000 miljoonaa Saksan markkaa). Kokonaistuen määrä on 218 718 000 euroa (427 775 000 miljoonaa Saksan markkaa) eli 19,8 prosenttia tukikelpoisista investointikustannuksista.

Tuen arviointi

Alustava arvio tuen soveltavuudesta yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti

Koska tuki myönnettiin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti tukialueella tehtävää uutta investointia varten, sitä on arvioitava aluetukena.

Tuki täyttää monialaisissa puitteissa esitetyt kolme kumuloidusta koskevaa perustetta, minkä vuoksi tuesta on ilmoitettava.

Tuki-intensiteetin sallitun enimmäismäärän (R) laskemisessa sovellettavia kolmea mukautuskerrointa on arvioitu saatavilla olevien tietojen perusteella seuraavasti:

Kilpailutekijä (T)

Asian kannalta merkitykselliseksi tuotemarkkinoiksi katsotaan DRAM-markkinat. Merkityksellisten markkinoiden katsotaan olevan maailmanlaajuiset.

Saksan antamien tietojen perusteella kyseisten markkinoiden ilmeisen kulutuksen kasvu hidastui vuosien 1995–2000 aikana (keskimäärin – 7,1 % vuodessa). Saksan viranomaiset väittävät, että suhdanteet DRAM-markkinoilla vaihtelevat jyrkästi, ja että kasvunäkymät ajanjaksolla 2001–2004 ovat hyvät, sillä markkinoiden arvioidaan kasvavan 22,9 prosenttia vuodessa. Tässä vaiheessa komissiolla ei ole luotettavia tietoja, joiden perusteella se pystyisi tarkasti selvittämään markkinatilanteen voidakseen määrittää kilpailutekijän oikein.

Pääoman ja työvoiman suhde

Kun 1 106 miljoonan euron (2 164 miljoonan Saksan markan) investoinnilla luodaan ja turvataan 1 700 uutta työpaikkaa, pääoman ja työvoiman suhde on 650 588 euroa/työpaikka. Tämän

mukaan suhdeluku olisi 0,8. Komissio epäilee kuitenkin, että kaikkia 1 700:aa uutta työpaikkaa ei voida ottaa huomioon. Tämä koskee etenkin tutkimus- ja kehitystyötä, jolla ei näytä olevan suoraa yhteyttä käsiteltävänä olevaan hankkeeseen. Tällaisten työpaikkojen tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Tässä vaiheessa ei voida jättää pois laskuista mahdollisuutta, että niiden suoraan luotavien työpaikkojen lukumäärä, jotka voidaan ottaa huomioon, vähenee niin paljon, että pääoman ja työvoiman suhde laskee suhdeluvun 0,8 soveltamista edellyttävän rajan alapuolelle.

Alueellista vaikutusta koskeva tekijä

Saksan viranomaisten mukaan investointi johtaa välillisesti arviolta 1 030:n työpaikan luomiseen. Suurin osa uusista työpaikoista olisi materiaalitoimitusten alalla. Näistä 600 olisi uudessa tehtaassa, jonka [...] (*) suunnittelee rakentavansa SC 300:ssa käytettävien 300 mm:n piikiekkujen valmistamiseksi. Saksan 16. heinäkuuta 2001 päivätyssä kirjeessä todetaan kuitenkin, että puolijohdemarkkinoiden nykyisen tilanteen vuoksi rakennusaikataulu on auki ja koko hankkeen toteutuminen on epävarmaa. Lisäksi Saksa väittää, että investointi johtaa välillisesti 100:n uuden työpaikan luomiseen, kun 300 mm:n testikiekkujen kierrätystä varten perustetaan uusi yhtiö. Tästä hankkeesta ei ole annettu muita tietoja.

Tässä vaiheessa komissio katsoo Saksan viranomaisten antamien tietojen perusteella, että [...] (*) hankkeeseen ja 300 mm:n testikiekkujen kierrätykseen liittyviä työpaikkoja ei voida ottaa huomioon.

Sallittu tuen enimmäismäärä

Saamiensa tietojen perusteella komissio epäilee, että 218 718 000 euron (427 775 000 Saksan markan) tuki, joka vastaa 19,8 prosentin bruttotuki-intensiteettiä, ei ole monialaisten puitteiden perusteella laskettavan tuen sallitun enimmäisintensiteetin mukainen.

Alustava arvio tuen soveltavuudesta yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti

Saksan mukaan tuki olisi todettava soveltuvaksi yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti. DRAM-tekniikan kehittämiseen on myönnetty EU:n tukea, ja tuen epääminen kyseisen tekniikan käyttöönottoa edistäviltä toimenpiteiltä vaikeuttaisi alkuperäisten tavoitteiden toteuttamista.

Komissio on esittänyt seuraavat neljä edellytystä sille, että tuki voidaan todeta yhteismarkkinoille soveltuvaksi 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti:

(*) Luottamuksellinen tieto.

- tuen on edistettävä jotakin hanketta; ”edistämisellä” tarkoitetaan toimintaa, joka myötävaikuttaa hankkeen toteutumiseen
- kyseessä on oltava täsmällinen ja tarkoin määritelty hanke
- hankkeen on oltava sekä määrällisesti että varsinkin laadullisesti merkittävä
- hankkeen on oltava Euroopan yhteistä etua koskeva ja siten hyödyllinen koko unionille.

Saksa ei ole esittänyt riittävästi tietoja, joiden perusteella komissio voisi arvioida, täyttyvätkö nämä edellytykset. Komissio toteaa, että tähän määräykseen vedotaan vain harvoin, ja silloinkin yleensä tutkimus- ja kehityshankkeiden yhteydessä. Määräyksen laajempi soveltaminen on perusteltava erikseen. Siksi komissio epäilee, että tuen ei voida katsoa täyttävän ehtoja, jotka on asetettu yhteismarkkinoille soveltuvuuden toteutamiselle.

KIRJEEN TEKSTI

”Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden über die vorerwähnte Beihilfe übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

1. VERFAHREN

- (1) Deutschland teilte der Kommission mit Schreiben vom 22. Mai 2001, Eingangsvermerk vom 28. Mai 2001 (A/34912), seine Absicht mit, der Infineon Technologies

SC 300 GmbH & Co. KG eine Investitionsbeihilfe gemäß dem multisektoralen Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben ⁽¹⁾ (im Folgenden: multisektoraler Regionalbeihilferahmen) zu gewähren. Das Beihilfevorhaben wurde unter der Nummer N 334/01 eingetragen.

- (2) Die Kommission bestätigte mit Schreiben vom 13. Juni 2001 (D/52365) den Erhalt des Schreibens, teilte Deutschland mit, dass die Anmeldung als unvollständig erachtet wird, und stellte ergänzende Fragen. Mit Schreiben vom 18. Juni 2001 (D/52463) wurde um weitere Auskünfte ersucht. Deutschland übermittelte Informationen mit Schreiben vom 3. Juli 2001, Eingangsvermerk vom 5. Juli 2001 (A/35358), und vom 16. Juli 2001, Eingangsvermerk vom 17. Juli 2001 (A/35792). Am 17. August 2001 fand eine Besprechung mit Vertretern der deutschen Behörden statt. Mit Schreiben vom 30. August 2001 (D/53554) forderte die Kommission Deutschland auf, die Bestimmungen über die nachträgliche Kontrolle in der Anmeldung zu ergänzen. Mit Schreiben vom 19. September 2001 (D/53827) wurde Deutschland daran erinnert, dass es ergänzende Angaben vorlegen sollte. Deutschland übermittelte mit Schreiben vom 24. September 2001, Eingangsvermerk vom 25. September 2001 (A/37455), unvollständige Informationen. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2001 (D/54027) bestätigte die Kommission den Erhalt und wies Deutschland darauf hin, dass die Anmeldung noch immer als unvollständig erachtet wurde. Deutschland übermittelte mit Schreiben vom 22. Oktober 2001, Eingangsvermerk vom 23. Oktober 2001 (A/38272), ergänzende Angaben. Mit Schreiben vom 26. Oktober 2001 (D/54438) teilte die Kommission Deutschland mit, dass die Anmeldung als unvollständig erachtet wird und innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag der Eintragung des Briefes mit den vollständigen Angaben eine abschließende Entscheidung getroffen wird.

- (3) Am 22. November 2001 übermittelte Deutschland ein endgültiges Schreiben, in welchem Deutschland darlegt, dass die Beihilfe nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrags als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar anzusehen seien.

⁽¹⁾ ABl. C 107 vom 7.4.1998, S. 7.

2. BESCHREIBUNG DER BEIHILFE

2.1 Beihilfeempfänger

- (4) Der Beihilfeempfänger, die Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG (im Folgenden: SC 300), wurde im Februar 1998 gegründet und ist eine 87%ige Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG (im Folgenden: Infineon) in München. Die Infineon selbst, die im März 2000 an die Börse ging, ist ein ausgegliedertes Unternehmen der Siemens AG und umfasst deren Halbleitergeschäft. Der restliche Anteil an der SC 300 befindet sich im Eigentum einer anderen privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (4 %, die über die SC 300 Beteiligungs GmbH in Stuttgart von der M+W Zander Facility Engineering GmbH kontrolliert werden) und einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die vom Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig kontrolliert wird (9 % — Leipziger Messe GmbH). Das Kerngeschäft der Infineon sind Halbleiter. Deutschland betont, dass die Infineon das einzige europäische Unternehmen auf diesem Markt ist.
- (5) Deutschland übermittelte die folgenden Daten über den Umsatz und den Personalstand der Infineon in den Jahren 1998 bis 2000:

	Weltweit		EWR		Deutschland	
	Umsatz (Mrd. EUR)	Mitarbeiter	Umsatz (Mrd. EUR)	Mitarbeiter	Umsatz (Mrd. EUR)	Mitarbeiter
1997/1998	3,175	21 816	1,816	14 401	1,078	11 237
1998/1999	4,237	24 541	2,444	15 543	1,241	12 352
1999/2000	7,283	27 210	3,259	16 603	1,612	13 522

- (6) Infineon verzeichnete 1997/98 einen Verlust von 775 Mio. EUR und 1998/1999 sowie 1999/2000 Gewinne von 61 Mio. EUR bzw. 1 126 Mio. EUR.

2.2 Das Vorhaben

- (7) Standort des Investitionsvorhabens ist Dresden im Freistaat Sachsen, einem Fördergebiet im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag.
- (8) Es betrifft die Errichtung von Anlagen für die Herstellung von dynamischen Halbleiterspeichern (Dynamic Random Access Memory — DRAM) mit Strukturbreiten von höchstens 0,14 µm auf 300-mm-Siliziumscheiben, die auch als „Wafer“ bezeichnet werden. Dies wird die weltweit erste Fertigungslinie für (Speicher-)Chips auf 300-mm-Wafern sein. Neben der Fertigungslinie wird die SC 300 mit den in ihrem Werk bereits vorhandenen Anlagen auch eine Pilot- und Entwicklungslinie betreiben.
- (9) Das Projekt läuft im April 2000 an und soll bis Ende 2003 abgeschlossen sein ⁽²⁾. Den Angaben zufolge wird die volle Kapazität letztlich 5 000 Wafer pro Woche erreichen. Für das Projekt sind zwei Ausbaustufen vorgesehen. Spätestens Ende 2001 wird die Hochvolumenfertigung aufgenommen, die noch deutlich unter der Endausbaukapazität liegen wird. In einer zweiten Ausbaustufe, die bis ungefähr Anfang 2003 dauert, wird die Produktionskapazität auf das maximale Niveau angehoben. Dieser stufenweise Ausbau ist den Angaben zufolge die wirtschaftlich tragfähigste Lösung, da sich insbesondere die künftige Massenfertigung dieser neuen Technologie noch in Entwicklung befindet.
- (10) Erzeugt werden DRAM mit einer Speicherkapazität von mindestens 512 Megabit. Diese DRAM werden nach und nach Speicherbausteine mit einer Kapazität von maximal 256 Megabit ersetzen. Infineon stellt diese DRAM mit niedrigerer Kapazität derzeit in Dresden, in den USA und in Taiwan her.
- (11) Der Schritt von der Verwendung von 200-mm-Wafern zu 300-mm-Wafern für die Erzeugung von Chips bedeutet, dass die Anzahl der Chips je Wafer (d. h. die Produktivität) ungefähr um das 2,5-fache ansteigen wird. Dadurch rechnet man wiederum mit einem Sinken der Herstellungskosten je Chip um 30 %—40 %. Darüber hinaus erlaubt die niedrigere Strukturbreite eine geringere Mindestgröße für die einzelnen Elemente, was kleinere und billigere Computerkomponenten ermöglicht.

- (12) Die Projektkosten können folgendermaßen aufgeschlüsselt werden:

⁽²⁾ Es scheint wahrscheinlich, dass es zu Verzögerungen kommen wird.

Punkt	Insgesamt		Beihilfefähig	
	Mio. DEM	Mio. EUR	Mio. DEM	Mio. EUR
Grundstücke	[..] (*)	[..]	[..]	[..]
Gebäude	[..]	[..]	[..]	[..]
Anlagen, Maschinen	[..]	[..]	[..]	[..]
Immaterielle Vermögenswerte	[..]	[..]	[..]	[..]
Sonstiges	[..]	[..]	[..]	[..]
Insgesamt	2 164	1 106	2 164	1 106

(*) Betriebsgeheimnis.

- (13) Durch das neue Projekt wird der weltweite Marktanteil von Infineon bei DRAM von 8 % im Jahr 1999 auf 10 % im Jahr 2003 ansteigen und im Bereich der Halbleiter von 3,5 % im Jahr 1999 auf 3,7 % im Jahr 2003 zunehmen.
- (14) Laut Deutschland werden durch die Investitionen 1 300 unbefristete Arbeitsplätze geschaffen und 400 unbefristete Arbeitsplätze erhalten. Es wird erwartet, dass das Projekt indirekt zur Schaffung von 1 030 Arbeitsplätzen im eigentlichen und in einem angrenzenden Fördergebiet führt.

2.3 Beihilfemaßnahmen

- (15) Das Beihilfevorhaben umfasst eine Investitionsbeihilfe in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von 172,255 Mio. DEM (88,073 Mio. EUR), der gemäß dem von der Kommission genehmigten 29. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gewährt werden soll. Eine Investitionszulage in Höhe von 252 Mio. DEM (128,85 Mio. EUR) soll auf der Grundlage des von der Kommission genehmigten Investitionszulagengesetzes 1999 ⁽³⁾ gewährt werden. Ferner wird eine 80%ige Bürgschaft für einen Kredit in Höhe von 880 Mio. DEM (450 Mio. EUR), die also 704 Mio. DEM abdeckt, im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung ⁽⁴⁾ übernommen. Die Beihilfeintensität ei-

⁽³⁾ Investitionszulagengesetz, C 72/98 (ex N 702/97), SG(98) D/12438 vom 30.12.1998 und SG(2001) D/28651 vom 2.3.2001.

⁽⁴⁾ Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin Ost, N 297/91, SG(91) D/1344 vom 15.7.1991 sowie E 24/95, SG(96) D/5500 vom 18.6.1996 und SG(98) D/54570 vom 11.11.1998.

ner Bürgerschaft für ein Unternehmen, das sich nicht in Schwierigkeiten befindet, beträgt 0,5 %, sodass der Barwert der Bürgerschaft 3,52 Mio. DEM (1,8 Mio. EUR) ausmachen wird. Die gesamte Beihilfe für den Begünstigten beläuft sich auf 427,775 Mio. DEM (218,178 Mio. EUR), was 19,8 % der beihilfefähigen Investitionskosten entspricht. Der nicht rückzahlbare Zuschuss wird nur für die erste Ausbaustufe des Projekts gewährt.

3. VORLÄUFIGE WÜRDIGUNG

3.1 Vorläufige Würdigung nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag

- (16) Die Beihilfe wurde für eine neue Investition in einem Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag gewährt und ist als Regionalbeihilfe zu würdigen.

3.1.1 Anmeldepflicht

- (17) Die beabsichtigte Beihilfe beträgt 427,775 Mio. DEM (218,718 Mio. EUR). Da sie somit über dem Schwellenwert von 50 Mio. EUR liegt, ist das Vorhaben gemäß dem multisektoralen Regionalbeihilferahmen anmeldepflichtig und muss entsprechend geprüft werden.

- (18) Vor der Würdigung des Beihilfevorhabens ist im multisektoralen Regionalbeihilferahmen die Ermittlung des relevanten Marktes vorgesehen.

3.1.2 Relevanter Markt

- (19) Der für die Ermittlung des Marktanteils relevante Produktmarkt umfasst das Produkt des Investitionsvorhabens und gegebenenfalls die Erzeugnisse, die vom Verbraucher oder Hersteller als Ersatzprodukte angesehen werden.

- (20) Im vorliegenden Fall betrifft die Investition die Erzeugung von DRAM. Diese fallen unter die Klasse 32.10 der NACE-Nomenklatur, die die Herstellung von elektronischen Bauelementen umfasst. Bei den DRAM handelt es sich um Halbleiter zur Speicherung binärer Daten. Halbleiter gehören zu den elektronischen Bauelementen. DRAM sind der gebräuchlichste Typ von Halbleiterspeichern. Ihre größten Anwendungsbereiche sind PC und kostengünstige Produktionen.

- (21) DRAM können nach ihrer Speicherkapazität (d. h. der Datenmenge, die auf den Chips gespeichert werden kann) eingeteilt werden. Diese Kapazität hängt von der Chipgeneration ab. Das Produkt unterliegt einem raschen technologischen Wandel, sodass alle drei bis vier Jahre eine neue Generation auf den Markt kommt. DRAM können auch nach ihrem Anwendungszweck oder der Art des Enderzeugnisses, in das sie eingebaut werden, unterschieden werden.

- (22) Es gibt auch andere Typen von Chips, wie zum Beispiel SRAM (Static Random Access Memories), EPROM (Electrically Programmable Read Only Memories), Flash-Speicher und ASIC (Application Specific Integrated Circuits). Im Allgemeinen erfüllen diese andere Funktionen als

DRAM und können nicht als Ersatzprodukte betrachtet werden.

- (23) DRAM sind Handelsware mit genormten Spezifikationen. Aus der Sicht der Nachfrageseite stehen den Kunden daher gleichartige DRAM von verschiedenen Herstellern auf der ganzen Welt zur Verfügung. Neue DRAM-Generationen stehen im Wettbewerb mit älteren. Die Entscheidung eines Kunden für einen spezifischen Typ hängt vom Verhältnis der Kosten zur Leistung und der Funktion des DRAM im Endprodukt ab.

- (24) Aus der Sicht der Angebotsseite können Hersteller DRAM mit unterschiedlicher Funktion mit denselben Produktionsanlagen erzeugen, da die verwendeten Technologien ähnlich sind. Die Umstellung zwischen verschiedenen Generationen von DRAM ist jedoch innerhalb einer bestimmten Anlage im Allgemeinen nicht leicht.

- (25) Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, den Markt für DRAM als den relevanten Produktmarkt⁽⁵⁾ zu betrachten. Für diesen Markt gibt es keine eigene Klasse in der NACE.

- (26) Hinsichtlich des relevanten geografischen Marktes kann festgehalten werden, dass die DRAM weltweit nach gleichen Spezifikationen und Marketingkonzepten gehandelt werden. Die Transportkosten sind niedrig, und es bestehen keine strukturellen Hindernisse für den Marktzugang. Deshalb wird der Weltmarkt als der relevante geografische Markt betrachtet.

3.1.3 Vorläufige Beurteilung nach dem multisektoralen Regionalbeihilferahmen

- (27) Gemäß dem multisektoralen Regionalbeihilferahmen muss die Kommission zur Festsetzung der zulässigen Beihilfehöchstintensität für ein angemeldetes Beihilfevorhaben zunächst die höchstzulässige Beihilfeintensität (Beihilfeobergrenze für Regionalbeihilfen) ermitteln, die ein Unternehmen in dem betreffenden Fördergebiet nach der zum Anmeldezeitpunkt gültigen Regionalbeihilferegelung in Anspruch nehmen kann.

- (28) Bei der höchstzulässigen Bruttobeihilfeintensität für das Gebiet, in dem SC 300 seinen Sitz hat, gibt es zwei Sätze für Großunternehmen, nämlich 28 % und 35 %. Die höchstzulässige Bruttobeihilfeintensität von 35 % wird nur angewandt, wenn die folgenden spezifischen Bedingungen kumulativ erfüllt sind: Auf Antrag eines Landes und mit Zustimmung des Unterausschusses des Planungsausschusses können in begründeten Ausnahmefällen strukturell besonders effizienten Maßnahmen für Regionen, die dem internationalen Standortwettbewerb ausgesetzt sind, höhere Fördersätze gewährt werden⁽⁶⁾.

- (29) Deutschland machte keine Angaben dazu, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Da Infineon als Großunternehmen zu betrachten ist, geht die Kommission derzeit davon aus, dass die höchstzulässige Bruttobeihilfeintensität (R) im vorliegenden Fall 28 % beträgt. Somit stellt die Kommission fest, dass die geplante Bruttobeihilfeintensität von 19,8 % unter der zulässigen Obergrenze für ein Großunternehmen in dieser Region liegt.

⁽⁵⁾ Diese Abgrenzung des relevanten Produktmarktes wurde von der Kommission auch im Fall JV.44, Hitachi/Nec, unter den Randnummern 14—20 angewandt (Entscheidung vom 3.5.2000).

⁽⁶⁾ ABl. C 340 vom 27.11.1999.

(30) Anschließend berichtigte die Kommission den Prozentsatz von 28 % um die Werte, die sich aus drei spezifischen Bewertungsfaktoren — nämlich dem Wettbewerbsfaktor (T), dem Faktor „Verhältnis Kapitaleinsatz — Arbeitsplätze“ (I) und dem Faktor „Regionale Auswirkungen“ (M) — ergeben, um die höchstzulässige Beihilfeintensität für das fragliche Vorhaben zu ermitteln.

Wettbewerbsfaktor (T)

(31) Die Kommission stellt fest, dass der Marktanteil von SC 300 und Infineon unter 40 % des relevanten Marktes liegt und diesen Wert aufgrund der neuen Investition auch nicht überschreiten wird. Infineon hatte 1999 einen Anteil von 8 % am DRAM-Markt. Nach Abschluss des Projekts im Jahr 2003 soll der Anteil von Infineon und SC 300 auf 10 % steigen.

(32) Die Genehmigung einer Beihilfe an Unternehmen in Sektoren mit struktureller Überkapazität birgt besondere Gefahren einer Wettbewerbsverfälschung. Jede Kapazitätserweiterung, die nicht durch eine Kapazitätskürzung an anderer Stelle ausgeglichen wird, wird das Problem der strukturellen Überkapazität verschärfen. Der (Teil-)Sektor wird nach der niedrigsten Stufe der NACE-Klassifizierung bestimmt. Gemäß Ziffer 3.4 des multisektoralen Regionalbeihilferahmens wird die Kommission, wenn ausreichende

(34) Da der Weltmarkt der relevante geografische Markt ist, legte Deutschland folgende Zahlen über den weltweiten sichtbaren Verbrauch von DRAM im Zeitraum 1995—2000 vor, die auf den Daten eines unabhängigen Forschungsinstituts ⁽⁷⁾ beruhen:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Mittlere Jahreszuwachsrate
Wert (Mrd. EUR)	41,793	25,528	19,952	14,028	20,713	28,907	- 7,1 %

(35) Laut diesen Zahlen betrug die mittlere Jahreszuwachsrate des sichtbaren Verbrauchs in den Jahren 1995—2000 - 7,1 %. In den fünf Jahren davor, d. h. von 1994 bis 1999, war die mittlere Jahreszuwachsrate des sichtbaren DRAM-Verbrauchs mit -3,1 % ebenfalls negativ.

(36) Darüber hinaus übermittelte Deutschland die folgende Prognose für die künftige Entwicklung des DRAM-Marktes, die von einem unabhängigen Forschungsinstitut ⁽⁸⁾ stammt:

	2001	2002	2003	2004	Mittlere Jahreszuwachsrate
Wert (Mrd. EUR)	14,194	17,001	22,926	26,374	22,9 %

(37) Die deutschen Behörden verweisen darauf, dass der DRAM-Markt von starken Schwankungen, insbesondere hinsichtlich der Preise, gekennzeichnet ist und Vorausagen für die Jahre 2001—2004 einen ausgeprägten Aufwärtstrend mit einer mittleren Jahreszuwachsrate von 22,9 % zeigen.

(38) Auf der Grundlage der vorhandenen Informationen verfügt die Kommission derzeit über keine zuverlässigen An-

Angaben zur Kapazitätsauslastung fehlen, zunächst prüfen, ob die Investition in einem schrumpfenden Markt erfolgt. Ein Markt gilt als schrumpfend, wenn die mittlere Jahreszuwachsrate des sichtbaren Verbrauchs des fraglichen Produkts in den letzten fünf Jahren mindestens 10 % unter dem Jahresdurchschnitt des gesamten verarbeitenden Gewerbes im EWR liegt, solange nicht ein starker Aufwärtstrend bei der relativen Zuwachsrate der Nachfrage nach dem Produkt vorliegt. Der Markt gilt als absolut schrumpfend, wenn die mittlere Jahreszuwachsrate des sichtbaren Verbrauchs über die letzten fünf Jahre negativ ist.

(33) Die niedrigste NACE-Stufe für die Herstellung von DRAM ist die Klasse 32.10, die alle Arten von elektronischen Bauelementen umfasst. Deutschland legte Zahlen über die Kapazität zur Erzeugung von DRAM vor und behauptete, dass die Kapazitäten beinahe zur Gänze ausgelastet sind (zwischen 95 % und 100 % in den letzten fünf Jahren). Da diese Angaben nicht der niedrigsten verfügbaren Stufe der NACE entsprechen und DRAM nur einen kleinen Teil dieser NACE-Klasse darstellen, stützt sich die Kommission gemäß Ziffer 3.4 des multisektoralen Regionalbeihilferahmens bei der Bewertung des Wettbewerbsfaktors auf den sichtbaren Verbrauch und prüft, ob die Investition in einem schrumpfenden Markt erfolgt.

gaben, um die genauen Merkmale des Marktes festzustellen und so den genauen Wettbewerbsfaktor anzusetzen.

Faktor „Verhältnis Kapitaleinsatz — Arbeitsplätze“ (I)

(39) Für sehr kapitalintensive Projekte sieht der multisektorale Regionalbeihilferahmen den Faktor „Verhältnis Kapitaleinsatz — Arbeitsplätze“ vor, durch den die Anpassung der höchstzulässigen Beihilfeintensität zugunsten von Projekten angestrebt wird, die effektiv und besser dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit durch die Schaffung einer relativ höheren Anzahl neuer Arbeitsplätze bzw. durch die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze zu verringern. Dieser Bewertungsfaktor berücksichtigt auch wettbewerbswidrige Auswirkungen der Beihilfe auf den Preis des Endprodukts.

(40) Der multisektorale Regionalbeihilferahmen legt ausdrücklich fest, dass erhaltene Arbeitsplätze nur berücksichtigt werden, soweit sie nachweislich unmittelbar mit der geplanten Investition zusammenhängen, eine umfangreiche Umschulung erfordern und beim Anlaufen des neuen Projekts entfallen würden.

(41) Im vorliegenden Fall werden 1 300 Arbeitsplätze geschaffen und 400 erhalten. Sie werden folgendermaßen aufgeteilt werden:

⁽⁷⁾ VLSI Research Inc.

⁽⁸⁾ Prognose von WSTS vom Frühling 2001.

	Erhaltene Arbeitsplätze	Neue Arbeitsplätze	Insgesamt
Management	9	1	10
Geschäftsführung	11	28	39
Produktionskontrolle	9	12	21
Produktionspersonal	177	584	761
Wartung im Produktionsbereich	64	204	268
Verfahrensingenieure	62	87	149
Prozessentwicklung	35	64	99
Automatisierung/IT/CIM	18	32	50
Anlagen		59	59
Technologie, Qualität, Produktkonzeption	15	90	105
Technologieentwicklung		102	102
Umweltschutz		6	6
Logistik		31	31
Summe	400	1 300	1 700

- (42) Die erhaltenen Arbeitsplätze betreffen die bereits bestehende Pilot- und Entwicklungslinie von SC 300. Wenn das neue Projekt nicht durchgeführt wird, würde laut Deutschland SC 300 seine Aktivitäten nicht fortsetzen, die Ausrüstung würde verkauft und die Arbeitsplätze gingen verloren. Folglich hängen die erhaltenen Arbeitsplätze direkt mit dem vorliegenden Projekt zusammen. Die Kommission entnimmt den Angaben, dass ein großer Teil dieser Arbeitsplätze mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die laufende Produktentwicklung verbunden sind.
- (43) Das Verhältnis Kapitaleinsatz — Arbeitsplätze ist beträchtlich niedriger als bei anderen Projekten im Halbleitersektor. Deutschland zufolge ist dies zum Teil auf die Integration von technischen Aktivitäten und Arbeitsplätzen im Bereich Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Die genaue Anzahl dieser Arbeitsplätze ist nicht bekannt. Die Kommission bezweifelt derzeit, dass alle direkten Arbeitsplätze bei der Berechnung des Faktors „Verhältnis Kapitaleinsatz — Arbeitsplätze“ berücksichtigt werden können. Dies gilt insbesondere für die Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung, da sie nicht direkt mit dem Projekt zusammenzuhängen scheinen.
- (44) Die Investitionskosten betragen 2,164 Mrd. DEM (1,106 Mrd. EUR). Wenn alle 1 700 direkten Arbeitsplätze berücksichtigt werden, dann entspricht der Faktor „Verhältnis Kapitaleinsatz — Arbeitsplätze“ dem Wert 650 588 EUR je Arbeitsplatz und kann somit auf 0,8 angesetzt werden. Derzeit kann allerdings, wie oben erläutert, nicht ausgeschlossen werden, dass die Anzahl der anrechenbaren direkten Arbeitsplätze herabgesetzt wird und unter den Wert 1 581 fällt, der die Untergrenze für die Anwendung eines Faktors „Verhältnis Kapitaleinsatz — Arbeitsplätze“ von 0,8 ist.

Faktor „Regionale Auswirkungen“ (M)

- (45) Mit dem Faktor „Regionale Auswirkungen“ wird der wirtschaftliche Nutzen für das Fördergebiet berücksichtigt. Die Arbeitsplatzschaffung kann nach Ansicht der Kommission als Indikator für den Beitrag eines Investitionsvorhabens zur regionalen Entwicklung gelten, wobei hierunter jene Arbeitsplätze zu verstehen sind, die unmittelbar durch das Projekt oder bei Direktlieferanten und -abnehmern entstehen. Kapitalintensive Investitionen können mittelbar zur

Schaffung von Arbeitsplätzen im eigentlichen oder einem angrenzenden Fördergebiet führen.

- (46) Laut Deutschland werden die Arbeitsplätze, die mittelbar infolge der Investition geschaffen werden, auf insgesamt 1 030 Stellen, vorwiegend im Bereich der Lieferanten, geschätzt. Diese werden sich folgendermaßen verteilen:

	Indirekte Arbeitsplätze
Lieferung von 300-mm-Siliziumscheiben	600
Aufbereitung von 300-mm-Testscheiben	100
Erweiterung der Infrastruktur (Werkschutz, Reinigung, Verpflegung der Mitarbeiter)	120
Materialzulieferung	40
Geräteservice	90
Transport	30
Gebäudeinfrastruktur	50
Insgesamt	1 030

- (47) Durch die Errichtung eines neuen Werks durch [. . .], das 300-mm-Siliziumscheiben an SC 300 liefern wird, sollen 600 indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden. In seinem Schreiben vom 16. Juli 2001 erklärte Deutschland, dass es aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage auf dem Halbleitermarkt nicht sicher ist, wann und ob das Projekt durchgeführt wird. Deshalb vertritt die Kommission derzeit, und auf der Grundlage der von Deutschland überbrachten Informationen bis zu diesem Zeitpunkt, die Ansicht, dass die mit diesem Projekt zusammenhängenden 600 Arbeitsplätze bei der Berechnung des Faktors „Regionale Auswirkungen“ nicht berücksichtigt werden können.
- (48) Ferner behauptet Deutschland, dass durch die Ansiedlung eines neuen Unternehmens für die Aufbereitung von 300-mm-Testscheiben im eigentlichen oder einem angrenzenden Fördergebiet 100 indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden. Zu diesem Projekt wurden keine weiteren Einzelheiten angegeben. Deshalb bezweifelt die Kommission derzeit, dass diese Arbeitsplätze berücksichtigt werden können.
- (49) In Bezug auf die restlichen indirekt geschaffenen Arbeitsplätze, die von Deutschland angeführt wurden, wurden keine weiteren Einzelheiten und Berechnungen übermittelt.
- (50) Daher kann in Anbetracht der von Deutschland überbrachten Informationen nicht ausgeschlossen werden, dass der Umfang der mittelbaren Arbeitsplätze geringer als 50 % der unmittelbaren Arbeitsplätze die durch das Projekt geschaffen werden ist. In einem solchen Fall hätte der Faktor „Regionale Auswirkungen“ keine positive Auswirkung auf die zulässige Beihilfeshöchstintensität.

3.1.4 Vorläufige Schlussfolgerung

- (51) In Anbetracht dessen hat die Kommission derzeit auf der Grundlage der verfügbaren Informationen Zweifel, ob der Betrag von 427,775 Mio. DEM (218,718 Mio. EUR), den Deutschland der SC 300 für ihre Investitionen in Dresden (Freistaat Sachsen) zu gewähren beabsichtigt und der einer Beihilfeintensität von 19,8 % brutto entspricht, mit der zulässigen Beihilfeshöchstintensität, die gemäß dem multi-sektoralen Regionalbeihilferahmen errechnet wurde, vereinbar ist.

3.1.5 Nachträgliche Kontrolle

- (52) In Anbetracht der Sensibilität der betroffenen Standort unabhängigen Großinvestitionen ist ein Mechanismus unabdingbar, der sicherstellt, dass die Höhe der tatsächlich gezahlten Beihilfe der Entscheidung der Kommission entspricht.
- (53) Für jedes von der Kommission gemäß dem multisektoralen Regionalbeihilferahmen genehmigte Beihilfevorhaben gilt daher, dass entweder der Beihilfevertrag zwischen der Behörde des Mitgliedstaats und dem Beihilfeempfänger eine Klausel enthält, die die Rückzahlung der Beihilfe bei Nichteinhaltung des Vertrags vorsieht, oder dass die letzte große Tranche der Beihilfe (z. B. 25 %) erst ausgezahlt wird, nachdem sich die Kommission anhand der vom Beihilfeempfänger stammenden Angaben des Mitgliedstaats von der entscheidungskonformen Durchführung des Vorhabens vergewissert und innerhalb von 60 Arbeitstagen der Zahlung der letzten Tranche der Beihilfe zugestimmt oder keine Einwände dagegen erhoben hat.
- (54) Die Kommission stellt fest, dass der Vorschlag für die Entscheidung über die Gewährung der Beihilfe an die SC 300 eine Klausel enthält, die die Rückzahlung der Beihilfe vorsieht, falls der Beihilfeempfänger gegen die Entscheidung über die Gewährung der Beihilfe verstößt.
- (55) Die Kommission stellt fest, dass die letzte große Tranche der Beihilfe erst ausgezahlt wird, wenn SC 300 dem Mitgliedstaat nachgewiesen hat, dass die Durchführung des Projekts der Entscheidung der Kommission entspricht.
- (56) Die Kommission stellt ferner fest, dass sich Deutschland dazu verpflichtet hat, dass die Anforderungen der nachträglichen Kontrolle gemäß Ziffer 6 des multisektoralen Regionalbeihilferahmens eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Pflicht zur Übermittlung eines Exemplars der Entscheidung über die Gewährung der Beihilfe sowie eines jährlichen Projektberichts und der weiteren in Ziffer 6.4 des multisektoralen Regionalbeihilferahmens genannten Informationen und Unterlagen an die Kommission.

3.2 Vorläufige Würdigung gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag

- (57) Deutschland argumentiert, dass das Projekt als Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse beurteilt werden soll, da die Gemeinschaft selbst die Entwicklung von 300-mm-Wafers im Rahmen von Eureka und des 5. Forschungsrahmenprogramms gefördert hat. Laut Deutschland würde eine begrenzte Unterstützung der Umsetzung der Technologie durch Gemeinschaftsbeihilfen gegen die Förderung dieser Technologie durch Gemeinschaftsmittel arbeiten. Infineon ist der einzige Hersteller von DRAM in Europa. Es liegt im gemeinsamen europäischen Interesse, dass Europa Speicher produziert, die zurzeit nur in den USA und Korea hergestellt werden.
- (58) Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag legt fest, dass Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse [...] als mit dem Gemein-

samen Markt vereinbar angesehen werden können. Die Kommission hat vier Kriterien festgelegt, um die Beschaffenheit eines Vorhabens von gemeinsamem europäischen Interesse zu prüfen⁽⁹⁾:

- mit der Beihilfe muss ein Vorhaben gefördert werden, wobei unter „Förderung“ eine Maßnahme zu verstehen ist, die zur Durchführung eines Vorhabens beiträgt;
- es muss sich um ein konkretes, genaues und klar definiertes Vorhaben handeln;
- das Vorhaben muss sowohl quantitativ als auch qualitativ von Bedeutung sein, besonders qualitativ;
- das Vorhaben muss von „gemeinsamem europäischen Interesse“ sein und als solches der gesamten Gemeinschaft nützen.

- (59) Deutschland hat keine Argumente übermittelt, dass diese vier Kriterien in dem betreffenden Vorhaben erfüllt wurden. Außerdem stellt die Kommission fest, dass diese Bestimmung sehr selten benutzt wird und hauptsächlich im Gebiet der Forschung und Entwicklung zur Anwendung kommt. Das Projekt von Infineon ist kein Forschungs- und Entwicklungsprojekt gemäß der Definition des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen. Die Anwendung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe b) EG-Vertrag in diesem speziellen Vorhaben würde einen neuen Anwendungsbereich schaffen und die Kommission hat Zweifel, ob dies gerechtfertigt ist.
- (60) Aus den dargelegten Gründen hat die Kommission Zweifel, ob die angemeldete Beihilfe zugunsten von SC 300 die Kriterien erfüllt, um gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b) als mit dem Markt vereinbar angesehen werden zu können.

4. ENTSCHEIDUNG

- (61) Angesichts der oben angeführten Schlussfolgerung hat die Kommission Zweifel, ob die angemeldete Beihilfe in Höhe von 427 775 000 DEM (218 718 134 EUR) mit einer Beihilfeintensität von 19,8 %, die Deutschland an SC 300 zu gewähren beabsichtigt, mit dem EG-Vertrag vereinbar ist, und hat beschlossen, gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens seine Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Beihilfe sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die deutschen Behörden, dem etwaigen Empfänger der Beihilfen unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

Die Kommission erinnert Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.”

⁽⁹⁾ Entscheidung der Kommission vom 13. März 1996 über eine steuerliche Beihilfe in Form einer Abschreibungsregelung zugunsten der deutschen Luftverkehrsunternehmen (ABl. L 146 vom 20.6.1996, S. 42).